

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 17 年 7 月 21 日 (2005.7.21)

【公開番号】特開 2003-229610 (P2003-229610A)
【公開日】平成 15 年 8 月 15 日 (2003.8.15)
【出願番号】特願 2002-25398 (P2002-25398)
【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 39/24

H 0 1 L 39/22

【F I】

H 0 1 L 39/24 Z A A J

H 0 1 L 39/22 A

【手続補正書】
【提出日】平成 16 年 11 月 26 日 (2004.11.26)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項 1】

基板表面上に c 軸配向の下部電極用酸化物超電導膜を形成し、パターンニングした後に層間絶縁膜を形成し、下部電極用酸化物超電導膜上の層間絶縁膜の一部をエッチングし層間絶縁膜の孔明け部分を形成し、その後、障壁層用薄膜と、c 軸配向の上部電極用酸化物超電導膜とを形成して、基板に接合部を形成する酸化物超電導接合基板の製造方法。

【請求項 2】

層間絶縁膜の孔明け部分を形成する際に下部電極用酸化物超電導膜の表面のエッチングを行ない、熱処理し、障壁層用薄膜を形成する請求項 1 に記載の酸化物超電導接合基板の製造方法。